三星电子一位高管周二表示，预计明年高带宽内存（HBM）将占到DRAM芯片制造商晶圆总产能的近30%，高于目前的约20%。

三星电子执行副总裁Kim Taewoo表示，HBM与标准DRAM争夺相同的晶圆产能，这意味着扩大HBM产量可能会限制标准DRAM的供应。

HBM是人工智能计算的关键组件，由垂直堆叠的存储芯片构成，使处理器能够高速访问海量数据。该市场目前主要由韩国的SK海力士和三星电子以及美国的美光科技主导。